

# Field effect transistors

Transistors à effet de champ - Feldeffekt-Transistoren

TYPE	RATINGS (at $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )						CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise stated)																		P O L A R I T Y	O U T L I N E S		
	$V_{GS}$	$V_{DS}$	$I_D$	$P_{tot}$	$T_{oper}$	$I_{GSS}$ at $V_{DS} = 0$	at		at		at		Conditions (a)		at		at		at		at		f	F			f	R <sub>C</sub>
	V	V	mA	mW	°C	nA	V	V	V	V	V	nA	V	V	nA	μmho	kHz	μmho	kHz	pF	MHz	pF						
	max	max	max	max	max	max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max	min-max			min-max	min-max
BFS76	40	40	50	360		0,25	20	8 - 80	15	0,8-4	15	0,5	0	10						18	1	8	1			N	110f	
BFS77	30	30	50	360		0,25	15	50	15	4 -10	15	0,5	0	10						18	1	8	1			N	110f	
BFS78	30	30	50	360		0,25	15	20-100	15	2 - 6	15	0,5	0	10						18	1	8	1			N	110f	
BFS79	30	30	50	360		0,25	15	8 - 80	15	0,8-4	15	0,5	0	10						18	1	8	1			N	110f	
BFS80	30	30	10	300		1	20	5 - 15	15	2,5-6	15	1	15	0		4,5-7,5	1	0,05	1	4	1	2	1	4	400	1kΩ	N	110Ad
BFT10	40	40	25	300	150	0,8	20	10	10					10	0	6-20	1			4'	15	1,5	1,5	1,4'	100	1kΩ	N	NS274c
BFT11	25	25	10	300	150		10	10	10					10	0	6-15	1			18	16	6	15			P	NS274c	
BFW10	30 <sup>1</sup>	30	20	300	200	0,1	20	8 - 20	15	8	15	0,5	15	0		3,5-6,5	1	85	1	5	1	0,8	1	2,5	100	1kΩ	N	110Ad
BFW11	30 <sup>1</sup>	30	20	300	200	0,1	20	4 - 10	15	6	15	0,5	15	0		3,0-6,5	1	50	1	5	1	0,8	1	2,5	100	1kΩ	N	110Ad
BFW12	30 <sup>1</sup>	30	20	300	200	0,1	30	2 - 10	15	6	15	0,5	15	0		3,0-6,5	1	20	1	6	1	3	1	100	10	N	110	
BFW54	50	50	10	150	200	0,1	30	2 - 10	15	6	15	0,5	15	0		3,0-6,5	1	20	1	6	1	3	1	40	10	N	110	
BFW55	50	50	10	150	200	0,1	30	2 - 10	15	6	15	0,5	15	0		3,0-6,5	1	20	1	6	1	3	1	40	10	N	110	
BFW56	50	50	10	150	200	0,1	30	2 - 10	15	6	15	0,5	15	0		3,0-6,5	1	20	1	6	1	3	1	20	10	N	110	
BFW61	25	25	20	300	200	1	20	2 - 20	15	8	15	1	15	0		2 - 6,5	1	85	1	6	1	2	1			N	110Ad	
BFW96	30	30	50	200			30	0 - 4,5	20	20μA	20		5		1,3				64	1	14				N	110Ad		
BSR56	40	40	50	360		0,25	20	50 -	15				0	10					18	1	8	1			N	110Ad		
BSR57	40	40	50	360		0,25	20	20-100	15				0	10					18	1	8	1			N			
BSR58	40	40	50	360		0,25	20	8 - 80	15				0	10					18	1	8	1			N			
BSV38	25	25	10	300	150	0,25	15	50	10	4 -10	15	0,5	0,75	0	20	25	1			18	1	8	1			N		
BSV38P	25	25	10	150	150	0,25	15	50	10	4 -10	15	0,5	0,75	0	20	25	1			18	1	8	1			N	NS148b	
BSV39	25	25	10	300	150	0,5	15	8 -100	10	0,8-6	15	0,5	0,75	0	20	70	1			18	1	8	1			N	NS142	
BSV39P	25	25	10	150	150	0,5	15	8 -100	10	0,8-6	15	0,5	0,5	0	20	70	1			18	1	8	1			N	NS142	
BSV78	40	40	50	350	175	0,25	20	50	15	3,75-11	15	1	0	10		25 Ω <sup>3</sup>	1			10	1	5	1			N	110f	
BSV79	40	40	50	350	175	0,25	20	20	15	2,0 - 7	15	1	0	10		40 Ω <sup>3</sup>	1			10	1	5	1			N	110f	
BSV80	40	40	50	350	175	0,25	20	10	15	1,0 - 5	15	1	0	10		60 Ω <sup>3</sup>	1			10	1	5	1			N	110f	
BSV81	10	10	30	50 <sup>2</sup>	200	1,75	0,01	10		5	10	1	0	5								0,5	1			N	110Ad	
Addendum:																												
BFW12	30	30	10	150	200	0,1	10	1 - 5	15	2,5	15	0,5	15	0		2	1	30	1	5	1	0,8	1			N	NS274c	
BFW13	30	30	10	150	200	0,1	10	0,2-1,5	15	1,2	15	0,5	15	0		1	1	10	1	5	1	0,8	1			N	NS274c	
BF907	20	50	150			100	5	3 - 30	15	5	15	20μ	15	(8)	10	14'	1			4'	1	0,25	1	2'	200	68	N	NS350
BF905	20	40	150			100	5	2 - 25	15	5	15	20μ	15	(8)	7	9'	1			2'	1	0,3	1	2,5'	200		N	NS350
BF961	20	30	200			100	5	2 - 25	15	4	15	20μ	15							2'	1	0,3	1	2,5'	200		N	NS364
BFQ20	40	40	10	38				0,3-1,5	15	0,5-4	15	0,5	15		300μ	0,85-1,2	1	2'	1	7	1	2	1	(ΔV <sub>GS</sub> = 25mV)		N	118	
BFQ21	40	40	10	38				0,3-1,5	15	0,5-4	15	0,5	15		300μ	0,85-1,2	1	2'	1	7	1	2	1	(ΔV <sub>GS</sub> = 50mV)		N	118	
BFQ25	25	10	300					10-40	6	1-5	6	0,5	6		10	0-16	1	100"	1	18	1	3,5	1			N	118	
BFQ26	see BFQ15 but: $I_{DSS1}/I_{DSS2} = 0,9$ min instead of 0,95 min																											

(<sup>1</sup>) typical value  
 (<sup>2</sup>) minimum value  
 (!) maximum value

(a) The conditions apply to all parameters (1) Open drain marked with (a), unless otherwise noted. (2) Peak

(3) Max  $r_{DS(on)}$  at  $V_{GS} = 0$ ;  $I_D = 0$   
 (4) at  $I_D = 1$  mA

(5) at  $V_{GS} = 10$  V;  $V_{DS} = 0$   
 (6) at  $V_{DS} = 5$  V  
 (7) MOS-FET-TETRODE  
 (8) at  $V_{GS} = 0$  V;  $V_{GS} = 4$  V